

연수 제안서

연구 분야	반도체 3차원 적층 및 2D 기반 소자 공정
연구 과제명	저온 공정 기반 실리콘계 M3D 고결정질 상부 소자층 형성 기술개발
연수 제안 업무	반도체 소재 및 소자 3차원 적층 공정
<div>(연수 내용)</div> <div>- : 2023.04.01.-2024.03.31. (포닥의 경우 최초 근로계약 기간 12개월)</div> <div>1. 화합물 및 Si(Ge) 반도체를 이용한 monolithic 3D integration 공정 기술 개발<ul style="list-style-type: none">- 에피 및 웨이퍼 본딩을 이용한 3차원 반도체 적층 공정 기술 개발- 적층된 반도체 상부층의 전기적 특성 분석 및 평가- MgO를 이용한 상부 반도체 층의 surface orientation 제어- 3-terminal artificial (optoelectronic) 시냅스 소자 및 응용 기술 개발</div> <div>채용 요건 :</div> <div>1. 관련 전공 박사학위 소지자 혹은 학위 취득 예정자</div> <div>2. 반도체 소자 공정 유경험자 우대</div>	
소속 부 서 : 차세대반도체연구소장실	
연수 책임자 : 김 형 준	